

Halbleiter

Preise siehe shop.griederbauteile.ch

STANDARD DIODEN	Seite 2 + 3
SCHOTTKY DIODEN	Seite 4
GERMANIUM, VARICAP, STABILISATOR	Seite 4
ZENER-DIODEN 0.5 WATT	Seite 5
ZENER-DIODEN 1 WATT	Seite 6
ZENER DIODEN 5 WATT	Seite 7
ZENER DIODEN 12.5 WATT	Seite 8
SCHUTZDIODEN	Seite 9
BRÜCKENGLEICHRICHTER	Seite 10
BIPOLARE TRANSISTOREN (15mA – 100mA)	Seite 11
BIPOLARE TRANSISTOREN (100mA – 500mA)	Seite 12
BIPOLARE TRANSISTOREN (600mA – 1.5A)	Seite 13
BIPOLARE TRANSISTOREN (2A - 10A)	Seite 14
BIPOLARE TRANSISTOREN (12A - 30A)	Seite 15
FELDEFFEKT-TRANSISTOREN (JFET)	Seite 16
POWER MOSFET	Seite 17
SCS – SILICON CONTROLLED SWITCH + DIAC	Seite 18
TRIACS	Seite 19
GE-TRANSISTOREN	

IF(A)	Durchlassstrom
IFAV(A)	Durchlassstrom (Mittelwert)
IFSM(A)	Stossdurchlassstrom (nicht periodisch)
IR(A)	Sperrstrom
trr(ns)	Rückerholzeit, Sperrverzögerungszeit (Sperrstrom = 10% v von IRM)
UF(V)	Durchlassspannung
UR(V)	Sperrspannung

Standard Dioden

Typ	UR(V)	IFAV(A)	IFSM(A)	UF(V) @ IF(A)	IR(A) @ UR(V)	trr(ns)	Gehäuse	Bezeichnung		
BY584	1800	0.085	0.8	8.5 0.1	3μ 1500	200	SOD-61	TV-Gleichrichterdiode		
BA103	6	0.1						Gleichrichter Diode		
BA102	20	0.1						Variable Capacitance Diode		
BA482	35	0.1						Diode		
1N4148	75	0.15	2	1 0.01	50μ 20	4	DO-35	Univ ersaldiode		
1N4151	50	0.2	2	1 0.05	50μ 50	4	DO-35	Univ ersaldiode		
BAX16	150	0.2				120		Diode		
BAS45	125	0.225	4	1 0.2	1n 125		DO-34	Low-leakage Diode		
BAV17	25	0.25						Diode		
BAV20	200	0.25				50		Diode		
BAV21	200	0.25	1	1.25 0.2	100μ 250	50	DO-35	Univ ersaldiode		
BY203-20	2000	0.25	20	2.4 0.2	100μ 2000	550	DO-7	Univ ersaldiode		
1N4448	100	0.3						Diode		
BAX18	75	0.4	6	1.5 2	100μ 75	50	DO-35	Univ ersaldiode		
BAX12	90	0.4	1	0.2 0.1	100n 90	50	DO-35	Av alanche-Diode		
BY207	500	0.4						Diode		
BYX10	1600	0.5						Diode		
BY208-1000G	1000	0.75						Diode		
BYV26C	600	1	30	2.5	1	1μ	600	30	SOD-57	Ultra Fast Soft-Recovery Ava.
BYV26E	1000						200	75		Ultra Fast Soft-Recovery Aval.
1N4007	1000	1	30	1.1	1	10	1000		58A2	Netz frequenz-Gleichrichter
1N4007G										SOD-57
SKS1-01	120	1.4	115	1.3	1.4	10	120		E3	Netz frequenz-Gleichrichter
SKS1-08	800									Netz frequenz-Gleichrichter
SKS1-16	1600									Netz frequenz-Gleichrichter
BYV95C	600	1.5	35	1.6	3	150μ	600	250	SOD-57	Av alanche Fast Soft Recov ery
BYV96E	1000						1000	300		Av alanche Fast Soft Recov ery
BYV27-100	100	2	50	1	3	1μ	100	25	SOD-57	Epitaxial Av alanche Diode
BYV27-200	200						200			Epitaxial Av alanche Diode
BYX55-350	350	2								Gleichrichter Diode
BYX55-600	600	2								Gleichrichter Diode
BYW56-TAP	1000	2	50	1 1	1μ 1000	2.2	SOD-57	Av alanche-Diode		
BYM26C	600	2.3	45	2.65	2	10μ	600	30	SOD-64	Ultra Fast Soft-Recovery Aval.
BYM26E	1000						1000	75		Ultra Fast Soft-Recovery Ava.
BYM36E	1000	2.9								Diode
BYM36C	600	3								Diode
BYW96E	1000	3	70	1.5 5	150μ 1000	300	SOD-64	Av alanche Fast Soft Recov ery		
1N5408RLG	1000	3	150	1.2 3	10 1000		DO-201AD	Netz frequenz-Gleichrichter		
BYV28-100	100	3.5	90	1.1	5	1μ	100	30	SOD-64	Epitaxial Av alanche Diode
BYV28-200	200						200			Epitaxial Av alanche Diode
BYX38-600	400	6	50	1.7	20	200μ	400		DO-4	Netz frequenz-Gleichrichter
BYX38-600R	400						400			Netz frequenz-Gleichrichter
BYX38-1200	800						800			Netz frequenz-Gleichrichter
BYX38-1200R	800						800			Netz frequenz-Gleichrichter
P600K	800	6								Netz frequenz-Gleichrichter
P600M	1000	6							P-6	Netz frequenz-Gleichrichter
GP610	1000	6	400	0.9 6	25 1000		E-27	Netz frequenz-Gleichrichter		
BYW29-100	100	8	80	0.8	8	0.6m	50	25	TO-220	Fast Recovery Diode
BYW29-200	200						200			Fast Recovery Diode
FES8JT	600	8								Gleichrichter Diode
BYR29-800	800	8	60	1.3 10	0.2m 600	75	TO-220	Fast Recovery Diode		
Typ	UR(V)	IFAV(A)	IFSM(A)	UF(V) @ IF(A)	IR(A) @ UR(V)	trr(ns)	Gehäuse	Bezeichnung		

IF(A)	Durchlassstrom
IFAV(A)	Durchlassstrom (Mittelwert)
IFSM(A)	Stossdurchlassstrom (nicht periodisch)
IR(A)	Sperrstrom
trr(ns)	Rückerholzeit, Sperrverzögerungszeit (Sperrstrom = 10% v von IRM)
UF(V)	Durchlassspannung
UR(V)	Sperrspannung

Standard Dioden

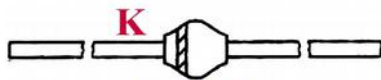
Fortsetzung

Typ	UR(V)	IFAV(A)	IFSM(A)	UF(V) @ IF(A)	IR(A) @ UR(V)	trr(ns)	Gehäuse	Bezeichnung
BYV34-400	400	2x10	120	0.93 @ 10	0.6m @ 400	50	TO-220	Fast Recovery Doppeldiode
BYV79-100	100	14	200	0.85 @ 10	1.3m @ 50	35	TO-220	Fast Recovery Diode
BYV79-200	200							Fast Recovery Diode
BYW30-200	200	14	150	0.8 @ 10	1.3m @ 200	30	DO-4	Fast Recovery Diode
BYX99-600	400	15	180	1.55 @ 50	200µ @ 400		DO-4	Netz frequenz-Gleichrichter
BYX99-600R	400							Netz frequenz-Gleichrichter
BYX99-1200	800							Netz frequenz-Gleichrichter
BYX99-1200R	800							Netz frequenz-Gleichrichter
BYV72-200	200	2x15	150	0.85 @ 10	1m @ 200	35	SOT-93	Fast Recovery Doppeldiode
BYV2-200	200	2x15	200	0.85 @ 10	1m @ 200	35	TO-220	Fast Recovery Doppeldiode
4AF2RPP	200	25						Netz frequenz-Gleichrichter D.
4AF6RPP	600	25						Netz frequenz-Gleichrichter D.
25FR80M	800	25						Gleichrichter Diode
BYW31-200	200	28	320	0.8 @ 30	1.5m @ 200	40	DO-4	Fast Recovery Diode
BYX96-600	400	30	400	1.7 @ 100	1m @ 400		DO-4	Netz frequenz-Gleichrichter
BYX96-600R	400							Netz frequenz-Gleichrichter
BYX96-1200	800							Netz frequenz-Gleichrichter
BYX96-1200R	800							Netz frequenz-Gleichrichter
40HF40	400	40						Standard Recovery Diode
BYX97-600	400	40	800	1.45 @ 150	4m @ 400		DO-5	Netz frequenz-Gleichrichter
BYX97-600R	400							Netz frequenz-Gleichrichter
BYX97-1200	800							Netz frequenz-Gleichrichter
BYX97-1200R	800							Netz frequenz-Gleichrichter
40HFR120	1200	40						Standard Recovery Diode
SKN45-12	1200	50						Gleichrichter Diode
70HF80M	800	70						Diode
70HFR80M	800	70						Diode

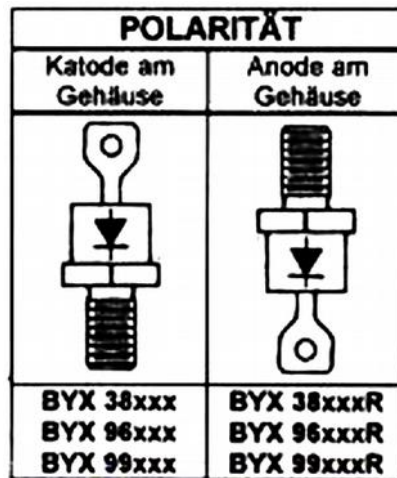


DO-7
DO-34
DO-35
DO-201

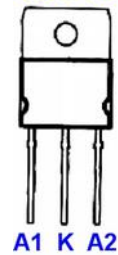
E-27
F-126
58A2



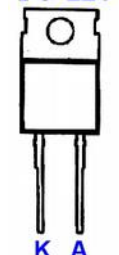
SOD-57
SOD-64



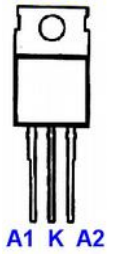
SOT-93



TO-220

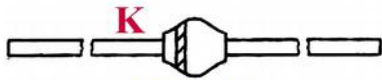


TO-220





SOD-61



SOD-57

SOD-64

CD(pf)	Diodenkapazität
f(MHz)	Frequenz
ID(A)	Drainstrom
IF(A)	Durchlassstrom
IFAV(A)	Durchlassstrom (Mittelwert)
IFRM(A)	Periodischer Spitzen-Durchlassstrom
IFSM(A)	Stossdurchlassstrom (nicht periodisch)
IR(A)	Sperrstrom
Rdiff	Differentieller Durchlasswiderstand
tn(ns)	Schaltzeit
trr(ns)	Rückholzeit, Sperrverzögerungszeit (Sperrstrom = 10% v von I _{RM})
Ttot(µs)	Totale Sperrverzögerungszeit (Sperrstrom Nennwert)
UF(V)	Durchlassspannung
UR(V)	Sperrspannung

Efficiency Diode = Für den Einsatz in transistorisierten horizontal Ablenkeinheiten.

Schottky-Barriere Schaltdioden (Hot-Carrier-Dioden) = speziell geeignet zur HF-Gleichrichtung

Best Nr	UR(V)	IF(A)	IFRM(A)	UF(V) @			IR(A) @ UR(V)		Ttot(µs)	trr(ns)	CD(pf)	Gehäuse	Beschrieb
				ID(A)	IF(mA)	IR(A)	UR(V)						
5082-2800	60	15m		410m	1m	200n	50			2.2	DO-35	Schottky-Barriere Schaltd	
BAT83	60	30m		410m	1m	200n	30		1	1.6	DO-34	Schottky-Barriere Schaltd	
BAT86	50	200m		400m	10m	2µ	25		4	8	DO-34	Schottky-Barriere Schaltd	
BY228	1500	5 max	10	1.5	5	200n	1500	4			SOD-64	Efficiency Diode	

Schottky Dioden

Typ	UR(V)	IFAV(A)	IFSM(A)	UF(V) @ IF(A)		IR(A) @ UR(V)		CD(pf)	Gehäuse	Bezeichnung
1N5819	40	1	25	0.6	1	1m	40	85	F-126	Schottky-Barriere Gleichrichter
1N5822	40	3	80	0.52	3	2m	40	190	DO-201	Schottky-Barriere Gleichrichter
STPS20H100CT	100	2x10								Dual Schottky Diode
PBYR1045	45	10	150	0.6	15	40m	35	200	TO-220	Schottky-Barriere Gleichrichter
PBYR1645		16						520		Schottky-Barriere Gleichrichter
PBYR2045CT	45	2x10	150	0.6	10	30m	25	300	TO-220	Dual Schottky-Barriere Gleichr
PBYR2545CT		2x15						500		Dual Schottky-Barriere Gleichr
BYV120-45	45	15	330	0.6	15	70m	45	520	DO-4	Schottky-Barriere Gleichrichter
BYV121-45		30	650					1150		Schottky-Barriere Gleichrichter

Germanium Dioden

Typ	UR(V)	IF(mA)	IFSM(A)	UF(V) @ IF(A)		Gehäuse
NTE110MP	30	15		0.22	500µ	DO-7
NTE110A	40	50	150	0.22	500µ	DO-7
AAZ78	20	180				
NTE109	100	200	400	0.42	10m	DO-7



DO-7

DO-34

DO-35

DO-201

E-27

F-126

58A2

Varicap (Kapazitätsdioden)

Typ	UR(V)	IF(mA)	CD(pf) @ UR(V)		CD(pf) @ UR(V)		Anwendungsbereich	Gehäuse	Bezeichnung
			min.	max.	min.	max.			
BB405B	30	20	1.8-2.2	28	11	3	UHF bis 860MHz	DO-34	
BB809	28	20	4-5	28	39-46	1	VHF bis 230MHz	DO-34	
BB909B	32	20	2.6-3	28	33.5	1	VHF bis 230MHz	DO-34	
BB212	12	100	22	8	500-620	0.5	AM-Radio	TO-92	Dual Diode
BB204G	30	100	14	30	34-39	3	FM-Radio	TO-92	Dual Diode

VHF-Bereichsumschaltungs-Diode

Typ	UR(V)	IF(mA)	CD(pf) @ UR(V) @ fMHz			Rdiff @ IF(mA) @ fMHz			Gehäuse
BA482	35	100	1.2	3	100	0.7	3	200	DO-34

Stabilisatordioden

Typ	UF(V)		IF(mA)	Rdiff @ IF(mA)		TKUF @ IF(mA)		URR(V)	IFM(mA)	Gehäuse
	min	max		Ohm		mV/°C				
BA315	0.59	0.66	1	50	1	-2.1	1	5	225	DO-35
BA314	0.68	0.76	1	30	1	-1.8	1	5	250	DO-35
BZV86-1V4	1.3	1.5	5	20	5	-3.8	5	10	250	DO-35
BZV86-2V0	1.85	2.15	5	30	5	-6	5	10	250	DO-35
BZV86-2V6	2.35	2.8	5	33	5	-8.5	5	10	150	DO-35
BZV86-3V2	2.85	3.45	5	35	5	-11.5	5	10	150	DO-35

Zenerdioden 0.5 Watt

UZ(V)	Z-Arbeitsspannung in Volt
rzj(Ω)	inhärenter differentieller Widerstand
TKUZ(10⁻⁴/K)	Temperaturkoeffizient der Z-Spannung
IZT(mA)	Z-Messstrom
IZM(mA)	Z-Maximalstrom

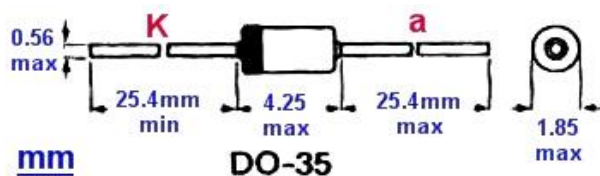
Gemeinsame Grenzwerte
 PD: 500mW
 RthJA: 380K/W
 TJ: 175°C
 Diese Werte gelten nur, wenn beide Anschlussdrähte in 4mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.

Wichtiger Hinweis

Diese Z-Dioden werden nach unserer Wahl (je nach Hersteller) mit verschiedenen Typen-Bezeichnungen geliefert, z.B.: BZV55C..., BZX79C..., BZX83..., ZPD...

Silizium Z-Dioden für Stabilisierungs- und Begrenzerschaltungen. Der als Katode bezeichnete Anschluss ist mit dem positiven Anschluss der Versorgungsspannung zu verbinden.

Best.Nr.	UZ(V)		rzj(Ω)	TKUZ(10 ⁻⁴ /K)		IZT(mA)	IZM(mA)	Gehäuse
	min	max		min	max			
Z04.2V4	2.28	2.56	90	-8	-6	5	155	DO-35 (Glas)
Z04.2V7	2.5	2.9	90	-8	-6	5	135	DO-35 (Glas)
Z04.3V0	2.8	3.2	90	-8	-6	5	125	DO-35 (Glas)
Z04.3V3	3.1	3.5	90	-8	-5	5	115	DO-35 (Glas)
Z04.3V6	3.4	3.8	90	-8	-4	5	105	DO-35 (Glas)
Z04.3V9	3.7	4.1	90	-7	-3	5	95	DO-35 (Glas)
Z04.4V3	4	4.6	85	-4	-1	5	90	DO-35 (Glas)
Z04.4V7	4.4	5	80	-3	1	5	85	DO-35 (Glas)
Z04.5V1	4.8	5.4	60	-2	5	5	75	DO-35 (Glas)
Z04.5V6	5.2	6	40	-1	6	5	70	DO-35 (Glas)
Z04.6V2	5.8	6.6	10	0	6	5	64	DO-35 (Glas)
Z04.6V8	6.4	7.2	8	1	6	5	58	DO-35 (Glas)
Z04.7V5	7	7.9	7	1	9	5	53	DO-35 (Glas)
Z04.8V2	7.7	8.7	7	1	9	5	47	DO-35 (Glas)
Z04.9V1	8.5	9.6	10	2	10	5	43	DO-35 (Glas)
Z04.10	9.4	10.6	15	3	11	5	40	DO-35 (Glas)
Z04.11	10.4	11.6	20	3	11	5	36	DO-35 (Glas)
Z04.12	11.4	12.7	20	3	11	5	32	DO-35 (Glas)
Z04.13	12.4	14.1	25	3	11	5	29	DO-35 (Glas)
Z04.15	13.8	15.6	30	3	11	5	27	DO-35 (Glas)
Z04.16	15.3	17.1	40	3	11	5	24	DO-35 (Glas)
Z04.18	16.8	19.1	50	3	11	5	21	DO-35 (Glas)
Z04.20	18.8	21.2	55	3	11	5	20	DO-35 (Glas)
Z04.22	20.8	23.3	55	3	11	5	18	DO-35 (Glas)
Z04.24	22.8	25.6	80	4	12	5	16	DO-35 (Glas)
Z04.27	25.1	28.9	80	4	12	5	14	DO-35 (Glas)
Z04.30	28	32	90	4	12	5	13	DO-35 (Glas)
Z04.33	31	35	90	4	12	5	12	DO-35 (Glas)
Z04.36	34	38	90	4	12	5	10	DO-35 (Glas)
Z04.39	37	41	130	4	12	5	9.5	DO-35 (Glas)
Z04.43	40	46	150	4	12	2	8.5	DO-35 (Glas)
Z04.47	44	50	170	4	12	2	8	DO-35 (Glas)
Z04.51	48	54	180	4	12	2	7	DO-35 (Glas)
Z04.56	52	60	200	4	12	2	6.5	DO-35 (Glas)
Z04.62	58	66	215	4	12	2	6	DO-35 (Glas)
Z04.68	64	72	240	4	12	2	5.5	DO-35 (Glas)
Z04.75	70	79	255	4	12	2	5	DO-35 (Glas)
Best.Nr.	min	max	rzj(Ω)	min	max	IZT(mA)	IZM(mA)	Gehäuse
	UZ(V)			TKUZ(10 ⁻⁴ /K)				



Zenerdioden 1 Watt

Gemeinsame Grenzwerte

PD: 500mW

RthJA: 380K/W

TJ: 150°C

Diese Werte gelten nur, wenn beide Anschlussdrähte in 4mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.

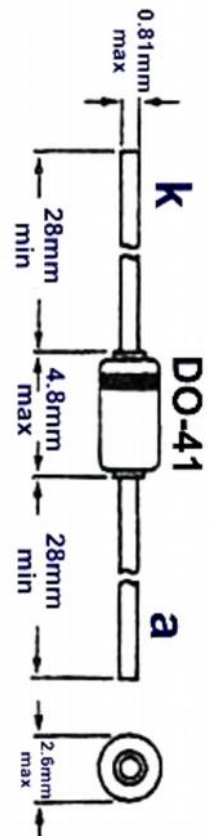
UZ(V)	Z-Arbeitsspannung in Volt
rzj(Ω)	inhärenter differentieller Widerstand
TKUZ(10⁻⁴/K)	Temperaturkoeffizient der Z-Spannung
IZT(mA)	Z-Messstrom
IZM(mA)	Z-Maximalstrom

Wichtiger Hinweis

Diese Z-Dioden werden nach unserer Wahl (je nach Hersteller) mit verschiedenen Typen-Bezeichnungen geliefert, z.B.: BZX85C..., PL..Z, ZPY..

Silizium Z-Dioden im Glasgehäuse DO-41 oder im Kunststoffgehäuse (nach unserer Wahl) für Stabilisierungs- und Begrenzerschaltungen. Der als Katode bezeichnete Anschluss ist mit dem positiven Anschluss der Versorgungsspannung zu verbinden.

Best.Nr.	UZ(V)		rzj(Ω)	TKUZ(10 ⁻⁴ /K)		IZT(mA)	IZM(mA)	Gehäuse	PD
	min	max		min	max				
Z11.2V7	2.5	2.9	10	-8	1	100	340	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.3V0	2.8	3.2	10	-8	1	100	310	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.3V3	3.1	3.5	10	-8	1	100	280	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.3V6	3.4	3.8	10	-8	1	100	260	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.3V9	3.7	4.1	7	-7	2	100	240	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.4V3	4	4.6	7	-7	3	100	210	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.4V7	4.4	5	5	-7	4	100	180	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.5V1	4.8	5.4	2	-6	5	100	170	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.5V6	5.2	6	2	-3	5	100	160	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.6V2	5.8	6.6	2	-1	6	100	145	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.6V8	6.4	7.2	2	0	7	100	130	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.7V5	7	7.9	2	0	7	100	120	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.8V2	7.7	8.7	2	3	8	100	110	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.9V1	8.5	9.6	4	3	8	50	100	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.10	9.4	10.6	7	5	10	50	90	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.11	10.4	11.6	7	5	10	50	82	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.12	11.4	12.7	7	5	10	50	75	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.13	12.4	14.1	9	5	10	50	67	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.15	13.8	15.6	9	5	10	50	60	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.16	15.3	17.1	10	6	11	25	56	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.18	16.8	19.1	11	6	11	25	53	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.20	18.8	21.2	12	6	11	25	48	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.22	20.8	23.3	13	6	11	25	44	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.24	22.8	25.6	14	6	11	25	44	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.27	25.1	28.9	15	6	11	25	40	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.30	28	32	20	6	11	25	35	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.33	31	35	20	6	11	25	31	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.36	34	38	60	6	11	10	28	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.39	37	41	60	6	11	10	24	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.43	40	46	60	7	12	10	22	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.47	44	50	80	7	12	10	20	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.51	48	54	100	7	12	10	18	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.56	52	60	100	7	12	10	16	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.62	58	66	100	8	13	10	14	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.68	64	72	130	8	13	10	13	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.75	70	79	160	8	13	10	12	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.82	77	88	160	8	13	10	11	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.91	85	96	250	9	13	5	10	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.100	94	106	250	9	13	5	9	DO-41 (Glas)	1.3W
Z11.110	104	116	250	9	13	5	8.2	DO-41 (Glas)	1.1W
Z11.120	114	127	250	9	13	5	7.5	DO-41 (Glas)	1.1W
Z11.130	124	141	300	9	13	5	6.7	DO-41 (Glas)	1.1W
Z11.150	138	156	300	9	13	5	6	DO-41 (Glas)	1.1W
Z11.160	153	171	350	9	13	5	5.6	DO-41 (Glas)	1.1W
Z11.180	168	191	350	9	13	5	5.2	DO-41 (Glas)	1.1W
Z11.200	188	212	350	9	13	5	4.7	DO-41 (Glas)	1.1W
Best.Nr.	min	max	rzj(Ω)	min	max	IZT(mA)	IZM(mA)	Gehäuse	PD
	UZ(V)			TKUZ(10 ⁻⁴ /K)					

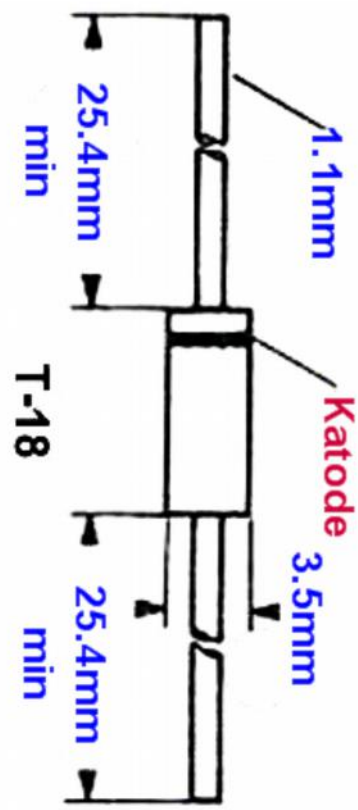


Zenerdioden 5 Watt

UZ(V)	Z-Arbeitsspannung in Volt
Δ(V)Z	Zenerspannungsänderung
rzj(Ω)	inhärenter differentieller Widerstand
IZT(mA)	Z-Messstrom
IZM(mA)	Z-Maximalstrom
IZSM(A)	Stossdurchlassstrom nicht periodisch

Gemeinsame Grenzwerte
 PD: 5W
 RthJA: 130K/W
 TJ: 150°C
 Toleranz UZ(V): ±5%
 Diese Werte gelten nur, wenn beide Anschlussdrähte in 10mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.

Best.Nr.	UZ(V)	Δ(V)Z	rzj(Ω)	IZT(mA)	IZM(mA)	IZSM(A)
1N5333B	3.3	0.85	3	380	1440	20
1N5334B	3.6	0.8	2.5	350	1320	18.7
1N5335B	3.9	0.54	2	320	1220	17.6
1N5336B	4.3	0.49	2	290	1100	16.4
1N5337B	4.7	0.44	2	260	1010	15.3
1N5338B	5.1	0.39	1.5	240	930	14.4
1N5339B	5.6	0.25	1	220	865	13.4
1N5341B	6.2	0.1	1	200	765	12.4
1N5342B	6.8	0.15	1	175	700	11.5
1N5343B	7.5	0.15	1.5	175	630	10.7
1N5344B	8.2	0.2	1.5	150	580	10
1N5346B	9.1	0.22	2	150	520	9.2
1N5347B	10	0.22	2	125	475	8.6
1N5348B	11	0.25	2.5	125	430	8
1N5349B	12	0.25	2.5	100	395	7.5
1N5350B	13	0.25	2.5	100	365	7
1N5352B	15	0.25	2.5	100	315	6.3
1N5353B	16	0.3	2.5	75	295	6
1N5355B	18	0.4	2.5	65	265	5.5
1N5357B	20	0.4	3	65	237	5.1
1N5358B	22	0.45	3.5	50	216	4.7
1N5359B	24	0.55	3.5	50	198	4.4
1N5361B	27	0.6	5	50	176	4.1
1N5363B	30	0.6	8	40	158	3.7
1N5364B	33	0.6	10	40	144	3.5
1N5365B	36	0.65	11	30	132	3.3
1N5366B	39	0.65	14	30	122	3.1
1N5367B	43	0.7	20	30	110	2.8
1N5368B	47	0.8	25	25	100	2.7
1N5369B	51	0.9	27	25	93	2.5
1N5370B	56	1	35	20	86	2.3
1N5372B	62	1.35	42	20	76	2.1
1N5373B	68	1.5	44	20	70	2
1N5374B	75	1.6	45	20	63	1.9
1N5375B	82	1.8	65	15	58	1.8
1N5377B	91	2.2	75	15	52.5	1.6
1N5378B	100	2.5	90	12	47.5	1.5
1N5379B	110	2.5	125	12	43	1.4
1N5380B	120	2.5	170	10	39.5	1.3
1N5381B	130	2.5	190	10	36.6	1.2
1N5383B	150	3	330	8	31.6	1.1
1N5384B	160	3	350	8	29.4	1.1
1N5386B	180	4	430	5	26.4	1
1N5388B	200	5	480	5	23.6	0.9
Best.Nr.	UZ(V)	Δ(V)Z	rzj(Ω)	IZT(mA)	IZM(mA)	IZSM(A)



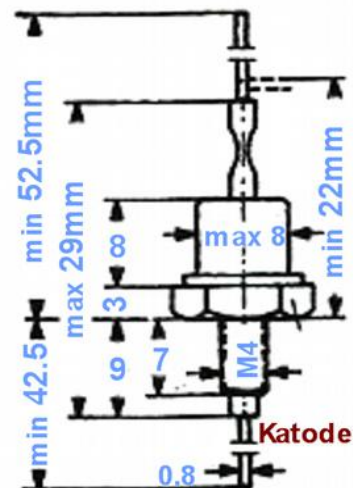
Zenerdioden 12.5 Watt

UZ(V)	Z-Arbeitsspannung in Volt
rzj(Ω)	inhärenter differentieller Widerstand
IZT(mA)	Z-Messstrom
IZM(mA)	Z-Maximalstrom
IZM+(mA)	Z-Maximalstrom (mit Kühlkörper)
RthJA	Sperrschicht zu Umgebung
RthJC	Sperrschicht zu Gehäuse

Gemeinsame Grenzwerte

Gesamtverlustleistung: 1.56W ohne Kühlkörper
 Gesamtverlustleistung: 12.5W mit Kühlkörper (125x125x2mm, senkrecht stehend)
 RthJA: 80K/W (mit Kühlkörper)
 RthJC: 5K/W
 Sperrschichttemperatur: 150°C
 Gehäuse: Metall mit M4 Schraubbolzen

Best.Nr.	UZ(V)		rzj(Ω)	TKUZ($10^{-4}/K$)		IZT(mA)	IZM(mA)	IZM+(mA)
	min	max		min	max			
ZX3,9	3.7	4.1	7	-7	2	100	280	2100
ZX4,3	4	4.6	7	-7	3	100	240	1750
ZX4,7	4.4	5	7	-7	4	100	210	1500
ZX5,1	4.8	5.4	5	-6	5	100	190	1430
ZX5,6	5.2	6	2	-3	5	100	180	1350
ZX6,2	5.8	6.6	2	-1	6	100	160	1250
ZX6,8	6.4	7.2	2	0	7	100	150	1150
ZX7,5	7	7.9	2	0	7	100	140	1060
ZX8,2	7.7	8.7	2	3	8	100	130	980
ZX9,1	8.5	9.6	4	3	8	50	117	890
ZX10	9.4	10.6	4	5	9	50	105	800
ZX11	10.4	11.6	7	5	10	50	95	710
ZX12	11.4	12.7	7	5	10	50	86	620
ZX13	12.4	14.1	10	5	10	50	76	560
ZX15	13.8	15.6	10	5	10	50	71	500
ZX16	15.3	17.1	10	6	11	50	65	465
ZX18	16.8	19.1	15	6	11	25	60	430
ZX20	18.8	21.2	15	6	11	25	55	400
ZX22	20.8	23.3	15	6	11	25	50	375
ZX27	25.1	28.9	15	6	11	25	40	320
ZX30	28	32	15	6	11	25	36	290
ZX33	31	35	15	6	11	25	33	260
ZX36	34	38	40	6	11	10	30	235
ZX39	37	41	40	6	11	10	28	210
ZX43	40	46	45	7	12	10	25	192
ZX47	44	50	45	7	12	10	22	175
ZX51	48	54	60	7	12	10	20	162
ZX56	52	60	60	7	12	10	18.5	150
ZX62	58	66	80	8	13	10	17	137
ZX68	64	72	80	8	13	10	15.5	125
ZX75	70	79	100	8	13	10	14	112
ZX91	85	96	200	9	13	5	11.5	92
ZX100	94	106	200	9	13	5	10.5	85
ZX110	104	116	250	9	13	5	9.5	77
ZX120	114	127	250	9	13	5	8.6	70
ZX130	124	141	300	9	13	5	7.8	63
ZX150	138	156	300	9	13	5	7	56
ZX160	153	171	350	9	13	5	6.3	51
ZX180	168	191	350	9	13	5	5.7	46
ZX200	188	212	350	9	13	5	5.2	42
Best.Nr.	min	max	rzj(Ω)	min	max	IZT(mA)	IZM(mA)	IZM+(mA)
	UZ(V)			TKUZ($10^{-4}/K$)				



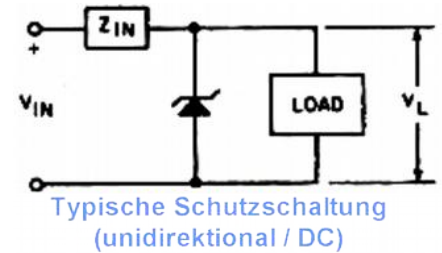
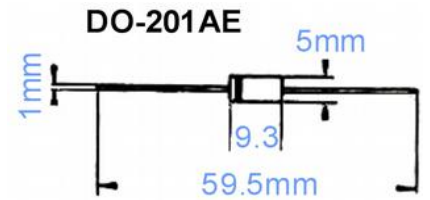
Schutzdioden unidirektional (DC)

UBR(V)	Durchbruchspannung
IR(mA)	Sperrstrom in mA
VCL	Abklemm-Spannung
Ipp(A)	Stossstrom
IR(µA)	Sperrstrom in µA
UR(V)	Sperrspannung

Schutzdioden (suppressor diodes) werden vor allem als Überspannungsschutz für Halbleiter verwendet.

Max. Belastung: 1.5kW/1ms
Gehäuse: DO-201AE (Plastik)

Best.Nr.	UBR(V) @ IR(mA)				VCL @ Ipp(A)		IR(µA) @ UR(V)	
	min	Nom	max	IR(mA)		max 1ms		
1.5KE6V8A	6.45	6.8	7.14	10	10.5	143	1000	5.8
1.5KE8V2A	7.79	8.2	8.61	10	12.1	124	200	7.02
1.5KE10A	9.5	10	10.5	1	14.5	103	10	8.55
1.5KE12A	11.4	12	12.6	1	16.7	90	5	10.2
1.5KE15A	14.3	15	15.8	1	21.2	71	5	12.8
1.5KE18A	17.1	18	18.9	1	25.2	59	5	15.3
1.5KE20A	19	20	21	1	27.7	24	5	17.1
1.5KE24A	22.8	24	25.2	1	33.2	45	5	20.5
1.5KE30A	28.5	30	31.5	1	41.4	36	5	25.6
1.5KE36A	34.2	36	37.8	1	49.9	30	5	30.8
1.5KE43A	40.9	43	43.2	1	59.3	25.3	5	36.8
1.5KE56A	53.2	56	58.8	1	77	19.5	5	47.8
1.5KE68A	64.6	68	71.4	1	92	16.3	5	58.1
1.5KE82A	77.9	82	86.1	1	113	13.3	5	70.1
1.5KE100A	95	100	105	1	137	11	5	85.5
1.5KE120A	114	120	126	1	165	9.1	5	102
1.5KE150A	143	150	158	1	207	7.2	5	128
1.5KE170A	162	170	179	1	234	6.4	5	145
1.5KE200A	190	200	210	1	274	5.5	5	171
1.5KE220A	209	220	231	1	328	4.6	5	185
1.5KE250A	237	250	263	1	344	4.3	5	214
1.5KE300A	285	300	315	1	414	3.6	5	256



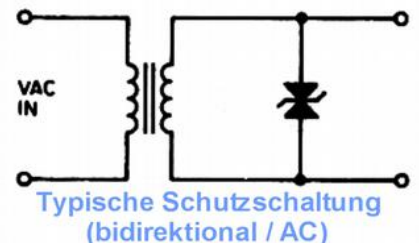
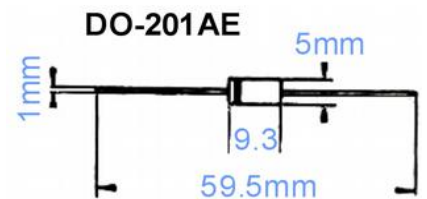
Computer Schutzdiode unidirektional (DC)

Für Mikroprozessoren, Integrierte Schaltungen, CMOS- und MOS Schaltkreise.

Best.Nr.	UBR(V) @ IR(mA)		VCL @ Ipp(A)		VCL @ Ipp(A)		VCL @ Ipp(A)		IR(µA) @ UR(V)	
1N5908	6	1	7.6	30	8	60	8.5	120	300	5

Schutzdioden bidirektional (AC)

Best.Nr.	UBR(V) @ IR(mA)				VCL @ Ipp(A)		IR(µA) @ UR(V)	
	min	Nom	max	IR(mA)		max 1ms		
1.5KE8V2CA	7.38	8.2	9.02	10	12.5	120	200	6.63
1.5KE12CA	10.8	12	13.2	1	17.3	87	5	9.72
1.5KE15CA	13.5	15	16.5	1	22	68	5	12.1
1.5KE24CA	21.6	24	26.4	1	34.7	43	5	19.4
1.5KE36CA	32.4	36	39.6	1	52	29	5	29.1
1.5KE43CA	38.7	43	47.3	1	61	24	5	34.8
1.5KE56CA	50.4	56	61.6	1	80.5	18.6	5	45.5
1.5KE68CA	61.2	68	74.8	1	98	15.3	5	55.1
1.5KE82CA	73.8	82	90.2	1	118	12.7	5	66.4
1.5KE100CA	90	100	110	1	144	10.4	5	81
1.5KE150CA	135	150	165	1	215	7	5	121
1.5KE200CA	180	200	220	1	287	5.2	5	162
1.5KE220CA	198	220	242	1	344	4.3	5	175
1.5KE250CA	225	250	275	1	360	4.2	5	202
1.5KE300CA	270	300	330	1	430	3.5	5	243



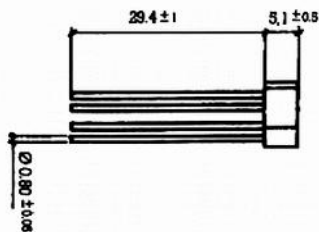
URRM(V)	Periodische Spitzenspersspannung
URMS(V)	Nenn-Anschlusswechselfspannung
IFAV(A)	Durchlassstrom (Mittelwert)
IFSM(A)	Stossdurchlassstrom (nicht periodisch)
UF(V)	Durchlassspannung
IF(A)	Durchlassstrom
CL(μF)	Maximaler Ladekondensator bei Rt
Rt0	Minimalwert des Serienwiderstandes (Innenwiderstand des Trafos einbezogen)

1) = der höhere Stromwert ist nur zulässig bei Montage auf ein Kühlblech von min 250 x 250 x 1mm

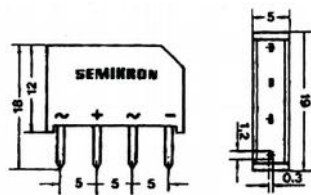
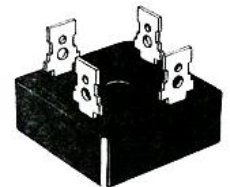
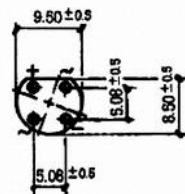
Brückengleichrichter

Best.Nr.	URRM(V)	URMS(V) Veff	IFAV(A) 1)		IFSM(A)	UF(V)	IF(A)	CL(μF)	Rt0	Gehäuse	Beschrieb
			R-Last	C-Last							
B80C800SI	180	80	0.8	0.8	45	2	0.8	2500	2.2	Rund	
B250C800SI	600	250	0.8	0.8	45	2	0.8	500	8.2	Rund	
CSB4	400	280	1	1	30	2.4	1			DIL	
B80C1500SI	180	80	1.5	1.5	45	2	1.5	2500	2.2	Rund	
B80C1500L5B	240	80	1.5	1.5	80	1.5	1.5	2200	1.1	SIL	
B380C1500SI		380	1.5	1.5						Rund	
B250C1500SI	600	250	1.5	1.5	45	2	1.5	500	8.2	Rund	
B500C1500L5B	1200	500	1.5	1.5	80	1.5	1.5	500	5	SIL	
B560C1500SI	1200	560	1.5	1.5	45	2	1.5	500	8.2	Rund	
DF06M		600	1.5	1.5						DIL	Nachfolger von CSB4
SKB2-02L5A	200	60	1.7/2.5	1.4/2.0	58	1.7	1.7	3000	1	SIL	Typ SKB 2/02 L5A
SKB2-08L5A	800	250						1000	3	SIL	Typ SKB 2/08 L5A
B80C3700-2200SI	200	80	2.7/4.0	2.2/3.2	115	1.1	3	3000	0.8	SIL	
B250C3700-2200SI	600	250	2.7/4.0	2.2/3.2	115	1.1	3	1700	1.6	SIL	
B80C5000-3300SI	200	80	4.0/6.0	3.3/5.0	250	1.1	5	10000	0.3	SIL	
B250C5000-3300SI	600	250	4.0/6.0	3.3/5.0	250	1.1	5	2500	0.8	SIL	
KBU8K		800	5								
DB610W	1000	350	6	4.8	125	1.2	3			Miniatur	Typ DB610W oder KBPC610
KBPC608		800	6								
DB1210W	1000	350	12	7.5	300	1.2	6	1000	4.7	Miniatur	Typ PB1010 (DB1210W)
DB2510T	1000	350	25	18	300	1.2	12	2000	2.7	Schraub	Typ GBPC2510 oder DB2510T
DB2508D3PH		800	25								3-Phasen Typ DB25-08
GBPC2510W-E4-51		1000	25								
36MB60A	600	250	35	28	400	2.4	35			Schraub	
36MB120A	1200	500	35	28	400	2.4	35			Schraub	
KBPC5008F		800	50								

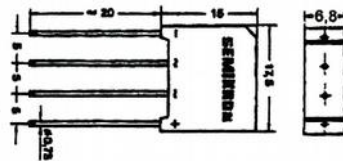
Schraub



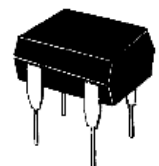
Rund



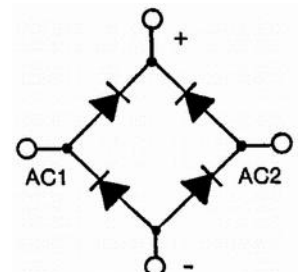
Bxxx C1500L5B






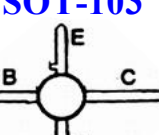



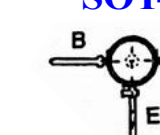
SKB2/0xL5A



CSB4



NPN	PNP	UCEO(V)	IC(A)	Ptot(W)	hFE @ IC(A)		ft(MHz)	Gehäuse	Beschrieb	Ersatz-Typ	
										NPN	PNP
BF182		20	15m							NTE161	
BF183		20	15m							NTE161	
BF180		20	20m							NTE161	
BF181		20	20m							NTE161	
BF200		20	20m							NTE161	
BFR90		15	25m						UHF 5 GHz wideband transistor		
BFY90		15	25m	150m	25-150	2m	t1000	TO-72(2)	HF Anwendungen UHF-Bereich		
BF173		25	25m							BF199	
BF199		25	25m	300m	38 >		t550	TO-92(2)	HF Anwendungen bis 100MHz		
BF198		30	25m		27 >						
	BF324	30	25m	250m	t50		t450	TO-92(1)	HF Anwendungen VHF-Bereich		
	BF414	30	25m	300m	30 >	1m	t400	TO-92(1)	HF Anwendungen VHF-Bereich		
BF414		30	25m						FM/VHF		
BF167		30	25m							BF198	
BF240		40	25m	250m	67-220	1m	t380	TO-92(2)	HF Anwendungen bis 100MHz		
BF241					36-125		t350				
	BF451		25m	250m	30-125		t325				
	BF450	40	25m	250m	60-220	1m	t325	TO-92(2)	HF Anwendungen bis 100MHz		
	BF441			300m	30-125		t250				
	BF440			300m	60-220		t250				
BF469	BF470	250	25m	2	50 >	25m	60	TO-126	NF- und Schaltanwendungen		
BF471	BF472	1) R300									
BFG65		10	30m	300m	25 -	15m	t7500	SOT-103			
BFR34A		12	30m	200m	25-50	14m	t5000	SOT-37			
BF480		15	30m	140m					HF Anwendungen UHF-Bereich		
BFR90		15	30m	200m	40-90	14m	t5000	SOT-37			
BFT66		15	30m	260m	30 -	10m	t4000	TO-72(1)			
BF495		20	30m	300m	36-125	1m	t200	TO-92(2)	HF Anwendungen bis 100MHz		
BF494					67-220		t200				
BF184		20	30m							BF240	
BF254		20	30m							BF240	
BF185		20	30m							BF241	
BF255		20	30m							BF241	
BF195		20	30m							BF495	
BF115		30	30m							BF494	
BFT66		50	30m								
BFR91		12	35m						UHF		
BFG65		10	50m						UHF		
BFR91		15	50m	250m	40-90	30m	t5000	SOT-37	HF Anwendungen UHF-Bereich		
BFY90		15	50m						HF Anwendungen UHF-Bereich		
2N918		15	50m							BFY90	
	BF479	25	50m	160m	20 -	10m	t1800	TO-50	HF Anwendungen UHF-Bereich		
BF422	BF423	250	50m	830m	50 >	25m	t60	TO-92(4)	HF Anwendungen bis 100MHz		
BFR96		15	75m	500m	25-80	50m	t5000	SOT-37	HF Anwendungen UHF-Bereich		
BFR96S		15	100m	700m	25-80	70m	t5000	SOT-37	HF Anwendungen UHF-Bereich		
	BC309C	20	100m								BC559C
BC108A	BC178A				110-220						
BC108B	BC178B				200-450						
BC108C	BC178C	20	100m	300m	420-800	2m	t130	TO-18	NF- und Schaltanwendungen		
BC109B	BC179B				200-450						
BC109C	BC179C				420-800						
BC131B		20	100m							BC549B	
BC131C		20	100m							BC549C	
2N5172		25	100m							(BC547B)	
BC548A	BC558A				110-220						
BC548B	BC558B	30	100m	500m	200-450	2m	t150	TO-92(1)	NF- und Schaltanwendungen		
BC548C	BC558C				420-800						
BC549B	BC559B	30	100m	500m	200-450	2m	t150	TO-92(1)	NF- und Schaltanwendungen		
BC549C	BC559C				420-800						
BC413C		30	100m							BC550C	
BC107A	BC177A	45	100m	300m	110-220	2m	t130	TO-18	NF- und Schaltanwendungen		
BC107B	BC177B				200-450						
BC547A	BC557A	45	100m	500m	110-220	2m	t150	TO-92(1)	NF- und Schaltanwendungen		
BC547B	BC557B				200-450						
BC550B	BC560B	45	100m	500m	200-450	2m	t150	TO-92(1)	NF- und Schaltanwendungen		
BC550CG	BC560CG				420-800						

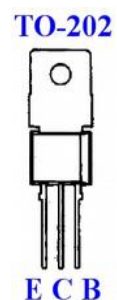
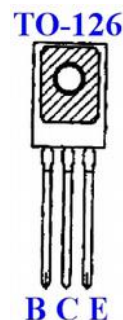
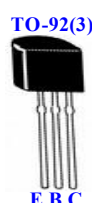
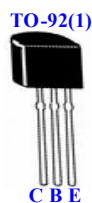
Fehler und Änderungen vorbehalten.
Bild kann vom Original abweichen

11

www.griederbauteile.ch
Edition Juli 2013

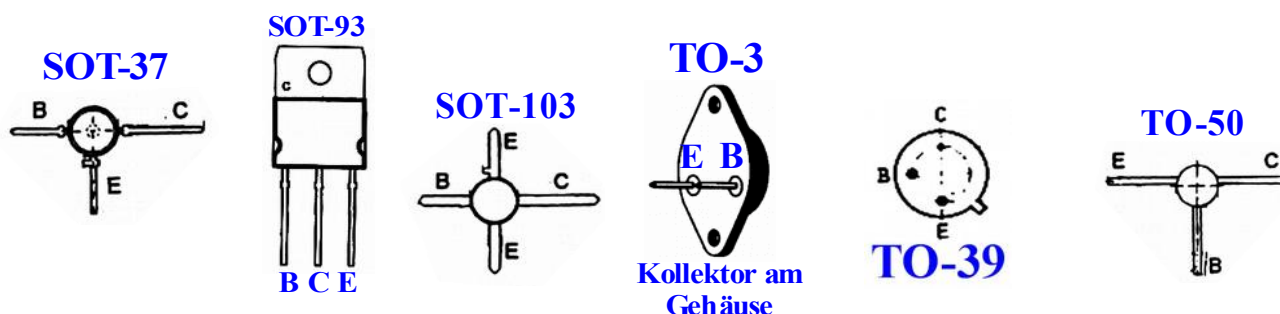
NPN	PNP	UCEO(V)	IC(A)	Ptot(W)	hFE @ IC(A)		ft(MHz)	Gehäuse	Beschrieb	Ersatz-Typ	
										NPN	PNP
	BC256B	64	100m								
	BC266A	64	100m								
	BC266B	64	100m								
BC190A		64	100m								
BC546A	BC556A	65	100m	500m	110-220	2m	t150	TO-92(1)	NF- und Schaltanwendungen		
BC546B	BC556B				200-450						
BSS38		100	100m	500m	20-80	4m	t60	TO-92(1)	NF- und Schaltanwendungen		
BF869	BF870	250									
BF871	BF872	300	100m	5	50 >	25m	60	TO-202	Video- und NF-Endstufen		
BF457		160									
BF458		250	100m	6	25 >	30m	t90	TO-126	NF- und Schaltanwendungen		
BF459		300									
BF819		250									
BF859		300	100m	6	45 >	20m	90	TO-202	Video- und NF-Endstufen		
BF258		250	100m								NTE154
BF259		300	100m								NTE154
BD115		180	150m								NTE154
	BC213B	30	200m								
	BC213C										
	BC214B	30	200m								
BCY58A	BCY78A				120-220						
BCY58B	BCY78B	32	200m	390m	180-310	2m	t180	TO-18	NF- und Schaltanwendungen		
BCY58C	BCY78C				250-460						
BCY58D	BCY78D				380-630						
BCY59A	BCY79A				120-220						
BCY59B	BCY79B	45	200m	390m	180-310	2m	t180	TO-18	NF- und Schaltanwendungen		
BCY59C	BCY79C				250-460						
BCY59D					380-630						
BC147A		45	200m								
BC1182A	BC212A	50	200m	300m	120-220	2m	t280	TO-92(1)	NF- und Schaltanwendungen		
BC182B	BC212B				180-460						
	2N1307	15	300m								
BF844		400	300m								
2N3553		40	330m	7	10-200	150m	t500	TO-39	HF Anwendungen VHF-Bereich		
BC517	BC516	30	400m	625m	30000>	20m	t250	TO-92(1)	Darlington-Transistor für NF+ Sch		
2N3866		30	400m	5	10-200	50m	t700	TO-39	HF Anwendungen VHF-Bereich		
BSY51		25	500m								
	BC192	25	500m								
PN2222A		40	500m								
	BC360-6										
	BC360-10	40	500m								
	BC360-16										
	BC361-6										
	BC361-10	60	500m								
BC340-6		40	500m								
BC340-10		40	500m								
BC340-16		40	500m								
BC341-6		60	500m								
BC341-10		60	500m								
2N1613		R50			40-120		60				
2N1711		R50	500m	3	100-300	150m	70	TO-39	NF- und Schaltanwendungen		
2N1893		80			40-120		50				
MPSA06	MPSA56	80	500m	500m	50>	10m	100	TO-92(3)	NF- und Schaltanwendungen		
BSY55		80	500m								
MPSA43	MPSA93	200									
MPSA42	MPSA92	300	500m	625m	1) 40/25-	10m	50	TO-92(3)	NF- und Schaltanwendungen		
MJE340	MJE350	300	500m	20	240			TO-126	Epitaxial Silicon Transistor		
BUX87		450	500m	20	t50	50m	t20	T-126	NF- und Schaltanwendungen		
NPN	PNP	UCEO(V)	IC(A)	Ptot(W)	hFE @ IC(A)		ft(MHz)	Geh.	Beschrieb	NPN	PNP
										Ersatz-Typ	

1) Die Angabe der DC-Stromverstärkung (hFE) nach dem Trennstrich ist gültig für den PNP-Typ

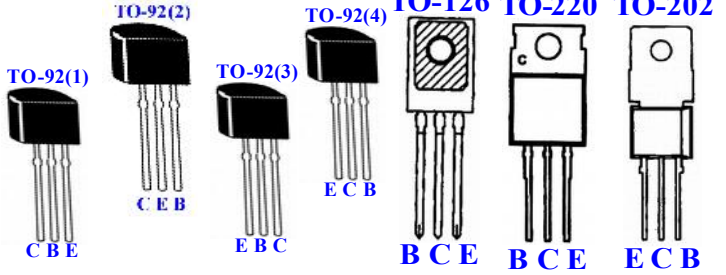


NPN	PNP	UCEO(V)	IC(A)	Ptot(W)	hFE @ IC(A)		ft(MHz)	Gehäuse	Beschrieb	Ersatz-Typ	
										NPN	PNP
2N2218A		40	600m								
	2N2906A	60	600m	400m	40-120	150m	200	TO-18	NF- und Schaltanwendungen		
	2N2907A				100-300						
	PN2907A	60	600m								
	2N2904A	60	600m	3	40-120	150m	200	TO-39	NF- und Schaltanwendungen		
	2N2905A				100-300						
	2N5401	150	600m	350m	60-240	10m	100	TO-92(3)	NF- und Schaltanwendungen		
2N5551		160			80-250						
2N3053		40	700m	5	50-250	150m	t30	TO-39	NF- und Schaltanwendungen	NTE128	
40314		40	700m								
BC338-16	BC328-16				100-250						
BC338-25	BC328-25	25	800m	500m	160-400	100m	t100	TO-92(1)	NF- und Schaltanwendungen		
BC338-40	BC328-40				250-600						
2N2221A		40	800m	500m	40-120	150m	250	TO-18	NF- und Schaltanwendungen		
2N2222A					100-300		300				
2N2218A		40	800m	3	40-120	150m	250	TO-39	NF- und Schaltanwendungen		
2N2219A					100-300		300				
BC337-16	BC327-16				100-250						
BC337-25	BC327-25	45	800m	500m	160-400	100m	t100	TO-92(1)	NF- und Schaltanwendungen		
BC337-40	BC327-40				250-600						
2N3053		40	700m	5	50-250	150m	t30	TO-39	NF- und Schaltanwendungen		
	2N4037		1	7	50-250		60				
BC368	BC369	20	1	800m	85-375	500m	t60	TO-92(4)	NF- und Schaltanwendungen		
BC375	BC376				60-340	150m	t150	TO-92(1)			
2N3553		40	1						VHF + UHF Bereich		
	BSV15-6										
	BSV15-10	40	1								
	BSV15-16										
	BC160-6	40									
BC140-10	BC160-10	40	1		63-160						
BC140-16	BC160-16	40			100-250						
BC141-6	BC161-6	60		3.7		100m	50	TO-39	NF- und Schaltanwendungen	BC141-10	
BC141-10	BC161-10	60	1		63-160						
BC141-16	BC161-16	60			100-250						
BC635	BC636	45			40-250						
BC637	BC638	60	1	800m	40-250	150m	t130	TO-92(4)	NF- und Schaltanwendungen		
BC639	BC640	80			40-250						
BSR50	BSR60	R45									
BSR51	BSR61	R60	1	800m	2000>	500m		TO-92(4)	Darlington-Transistor für NF+ Sch		
BSR52	BSR62	R80									
BSS50	BSS60	R45									
BSS51	BSS61	R60	1	5	2000>	500m		TO-39	Darlington-Transistor für NF+ Sch		
BSS52	BSS62	R80									
BD135	BD136	45			40-250						
BD137	BD138	60	1	8	40-160	150m	50	TO-126	Für NF- und Schaltanwendungen		
BD139	BD140	80			40-160						
BC618		55	1	625m	10000>	10m	100	TO-92(1)	Darlington-Transistor für NF+ Sch		
BD827	BD828	60	1	0.8	40-250	150m	75	TO-202	Für NF- und Schaltanwendungen		
	BSV16-6	60	1								
2N2102		65	1	5	40-120	150m	60	TO-39	NF- und Schaltanwendungen		
	2N4036			7	40-120						
	BSV17-10	80	1								
	2N4033	80	1	4	100-300	100m	100	TO-39	NF- und Schaltanwendungen		
	2N5415	200	1								NTE397
2N3439		350	1	10	40-160	50m	t30	TO-39	NF- und Schaltanwendungen		
	2N5416	300			30-120						
2N3440		350	1	10	40-160	50m	t30	TO-39	NF- und Schaltanwendungen		
	2N5415	300			63-150						
MPSA14		30	1.2						Darlington-Transistor für NF+ Sch		
BSX45-6		40	1.5							NTE128	
BSX45-10		40	1.5							NTE128	
BSX45-16		40	1.5							NTE128	
BSX46-10		60	1.5							NTE128	
BSX46-16		60	1.5							NTE128	
BSX47-10		80	1.5							NTE128	
NPN	PNP	UCEO(V)	IC(A)	Ptot(W)	hFE @ IC(A)		ft(MHz)	Geh.	Beschrieb	NPN	PNP
										Ersatz-Typ	

NPN	PNP	UCEO(V)	IC(A)	Ptot(W)	hFE @ IC(A)		ft(MHz)	Gehäuse	Beschrieb	Ersatz-Typ	
										NPN	PNP
BD233	BD234	45	2	25	40-250	150m	3	TO-126	Für NF- und Schaltanwendungen		
BD235	BD236	60									
BD237	BD238	80									
NSDU45A		50	2						Darlington-Transistoren NF + Sch		
2N5321	2N5323	50	2	10	40-250	500m	50	TO-39	NF- und Schaltanwendungen		
2N5320	2N5322	75			30-130						
BD815	BD816	60	2	12.5	25 >	500m	3	TO-202	Für NF- und Schaltanwendungen		
BD239A	BD240A	60	2	30	15 >	1	3	TO-220	Für NF- und Schaltanwendungen		
BD239C	BD240C	100									
	BD240B	80									
BUX67A		250	2							NTE369	
	BUX66A	300	2								
BUX85		450	2								
BU205		700	2.5								
BU505		700	2.5								
BU705		700	2.5								
BD241A	BD242A	60	3	40	25 >	1	3	TO-220	Für NF- und Schaltanwendungen		
BD241B		80									
BD241C	BD242C	100									
2N3441		140	3							NTE384	
BD437	BD438	45	4	36	40-375	500m	3	TO-126	Für NF- und Schaltanwendungen		
BD439	BD440	60			40-236						
BD441	BD442	80			40-236						
2N5190	2N5193	40	4	40	25-100	1.5	2	TO-126	Für NF- und Schaltanwendungen		
2N5191	2N5194	60			25-100						
2N5192	2N5195	80			20-80						
BD675	BD676	45	4	40	750 >	1.5	3	TO-126	Darlington-Transistoren NF + Sch		
BD677	BD678	60									
BD679	BD680	80									
BD681	BD682	100									
T1PL760C		550	4						Darlington-Transistoren NF + Sch		
BU209A		800	4								
BFX34		60	5	5	40-150	2	70	TO-39	NF- und Schaltanwendungen		
BSS45	BSS46	80	5	5	30 >	2	70	TO-39	NF- und Schaltanwendungen		
2N5240		300	5							NTE94	
BUT11A		450	5							NTE163A	
BU207A		600	5								
BU208A		700	5								
BU208D		700	5								
40632		60	6							MJE3055T	
BD243A	BD244A	60	6	65	15 >	3	3	TO-220	Für NF- und Schaltanwendungen		
BD243B		80									
BD243C	BD244C	100									
BU826		375	6						Darlington-Transistoren NF + Sch		
BU426A		400	6							NTE2310	
BUX82		400	6							NTE283	
BUX83		450	6							NTE283	
BU903		550	6								
BU608		200	7								
BU608D		200	7								
TIP152		400	7	80	50 >	5		TO-220	Darlington-Transistoren NF + Sch		
	BDX62	60	8						Darlington-Transistoren NF + Sch		NTE244
	MJ900	60	8						Darlington-Transistoren NF + Sch		MJ901
MJ1001	MJ901	80	8	90	1000 >	3		TO-3	Darlington-Transistoren NF + Sch		
	BDX62B	100	8						Darlington-Transistoren NF + Sch		NTE2350
BU433		375	8							NTE2310	
BUS12A		450	8							NTE2311	
BU508A		700	8								
BU508D		700	8								
NPN	PNP	UCEO(V)	IC(A)	Ptot(W)	hFE @ IC(A)		ft(MHz)	Geh.	Beschrieb	NPN	PNP
										Ersatz-Typ	



UCEO(V)	Kollektor-Emitter Sperrspannung bei offener Basis
IC(A)	Kollektorgleichstrom
Ptot(W)	Gesamtverlustleistung
hFE	DC-Stromverstärkung IC/IB
ft(MHz)	Transitfrequenz
(-.....)	Angabe in Klammern nach dem Trennstrich ist gültig für den PNP-Typ

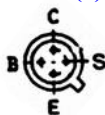


NPN	PNP	UCEO(V)	IC(A)	Ptot(W)	hFE @ IC(A)	ft(MHz)	Gehäuse	Beschrieb	Ersatz-Typ		
									NPN	PNP	
MJE3055T	MJE2955T	60	10	75	20 – 70	4	2	TO-220	Für NF- und Schaltanwendungen		
BDY90		100	10	40	30 – 120	5	4	TO-3	Für NF- und Schaltanwendungen		
BDX33A	BDX34A	60	10	70	750 >	4		TO-220	Darlington-Transistoren NF + Sch		
BDX33C	BDX34C	100									
BDX33D	BDX34D	120									
BD245A	BD246A	60	10	80	20 >	3		SOT-93	Für NF- und Schaltanwendungen		
BD245C	BD246C	100									
TIP140	TIP145	60	10	125	1000 >	5		SOT-93	Darlington-Transistoren NF + Sch		
TIP142	TIP147	100	10								
MJ3001	MJ2501	80	10	150	1000 >	3		TO-3	Darlington-Transistoren NF + Sch		
BDX95		100	10								NTE280
2N3442		140	10	117	20 – 70	3	0.8	TO-3	Für NF- und Schaltanwendungen		
TIP160		320	10	50	200 >	4		SOT-93	Darlington-Transistoren NF + Sch		
TIP162		380									
TIP660		320	10	80	200 >	4		TO-3	Darlington-Transistoren NF + Sch		
TIP662		380									
BUT12A		450	10								
	BDX64	60	12						Darlington-Transistoren NF + Sch		NTE248
BDX65A		80	12						Darlington-Transistoren NF + Sch	NTE247	
BDT65B	BDT64B	100	12	125	1000 >	5		TO-220	Darlington-Transistoren NF + Sch		
BDX65B		100	12						Darlington-Transistoren NF + Sch	NTE247	
	BDX64B	100	12						Darlington-Transistoren NF + Sch		NTE248
	BDX64C	120	12						Darlington-Transistoren NF + Sch		NTE2350
BDX65C		120	12						Darlington-Transistoren NF + Sch	NTE2349	
MJE13009		400	12								
BUX88		800	12								
2N6486	2N6489	40	15	75	20 – 150	5	t10	TO-220	Für NF- und Schaltanwendungen		
2N6487	2N6490	60									
2N6488	2N6491	80									
2N3055	MJ2955	60	15	115	20 – 70	4	0.8	TO-3	Für NF- und Schaltanwendungen		
TIP3055	TIP2955	2) R70	15	100	20 – 70	4		SOT-93	Für NF- und Schaltanwendungen		
BD743B	BD744B	80	15	90	20 – 150	5	5	TO-220	Für NF- und Schaltanwendungen		
BD183		80	15								2N3773
	BDW47	100	15						Darlington-Transistoren NF + Sch		
BDW42		100	15						Darlington-Transistoren NF + Sch		
BDT85		100	15	125	50 >	5	10	TO-220	Für NF- und Schaltanwendungen		
BDW51C	BDW52C	100	15	125	20 – 150	5		TO-3	Für NF- und Schaltanwendungen		
BDW83A	BDW84A	60	15	150	750 >	6		SOT-93	Darlington-Transistoren NF + Sch		
	BDW84B	80									
BDW83D	BDW84D	120									
BUV48A		400	15								
BUX48		400	15								
	BDX66	60	16						Darlington-Transistoren NF + Sch		NTE250
BDX67		60	16						Darlington-Transistoren NF + Sch	NTE249	
	BDX66B	100	16						Darlington-Transistoren NF + Sch		NTE250
	BDX66C	120	16						Darlington-Transistoren NF + Sch		
2N3773		140	16								
	2N6609	140	16								
BDV67D		150	16	200	1000 >	10		SOT-93	Darlington-Transistoren NF + Sch		
2N6282	2N6285	60	20	160	750 >	10		TO-3	Darlington-Transistoren NF + Sch		
2N6283	2N6286	80									
2N6284	2N6287	100									
MJ15003	MJ15004	140	20	250	25 – 150	5	2	TO-3	Für NF- und Schaltanwendungen		
BD249A	BD250A	60	25	125	10 >	15		SOT-93	Für NF- und Schaltanwendungen		
BD249C	BD250C	100									
	TIP36C	100									
2N3771		40	30			15	0.2	TO-3	Für NF- und Schaltanwendungen		
2N3772		60	30	150	15 – 60	10					
2N3773	2N6609	140	16			8					
MJ802	MJ4502	90	30	200	25 – 100	7.5	2	TO-3	Für NF- und Schaltanwendungen		
40411		90	30								NTE181

TO-72(1)

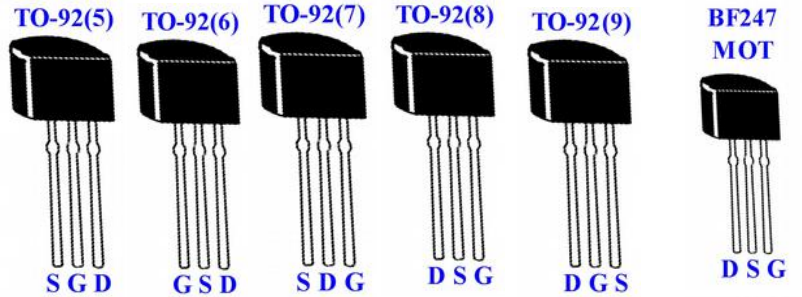


TO-72(2)

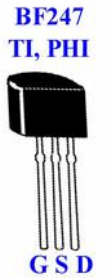


2) Basis über einen Widerstand mit Masse (NPN-Typ) bzw. Pluspol (PNP-Typ) verbunden.

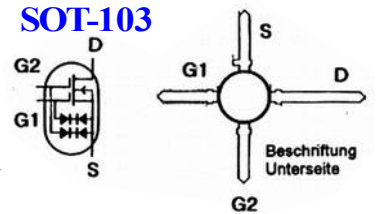
UDS(V)	Drain-Source Spannung
IG(mA)	Gate-Vorwärtsstrom
ID(mA)	Drainstrom
Ptot(W)	Gesamter Verlustleistung
IDSS(mA)	Sättigungs-Drainstrom (Gate kurzgeschlossen)
-U(P)GS(V)	Gate-Source Abschlußspannung (FET sperrt)
gfs(mAV)	Vorwärtssteilheit
f(Hz)	Frequenz
RDson(Ω)	Drain-Source Einschaltwiderstand
Ton(ns)	Einschaltzeit
Toff(ns)	Ausschaltzeit



Best.Nr.	UDS(V)	IG(mA)	Ptot(W)	IDSS(mA) @ UDS(V)	-U(P)GS(V)	gfs(mAV) @ f(Hz)	Geh.	Beschrieb
BC264A	30	10	300	2 – 4.5	15	2.5 >	TO-92(6)	N-Kanal für HiFi-Verst.
BC264B				3.5 – 6.5		3 >		
BC264C				5 – 8		3.5 >		
BC264D				7 – 12		4 >		
2N5457	25	10	310	1 – 5	15	0.5 – 6	TO-92(8)	N-Kanal für HiFi-Verst.
2N5458				2 – 9		1 – 5		
2N5459				4 – 16		1.5 – 5.5		
2N5460	-15	-10	350	1 – 5	-15	0.8 – 6	TO-92(7)	P-Kanal für HiFi-Verst.
2N5461		-10		1 – 7				
2N5462		-16		1.5 – 5				
2N3820	-20	-15	200	15	-10	8	TO-92(5)	P-Kanal für HiFi-Verst.



BF246/247A-C: für VHF- und UHF-Verstärker und allgemeine Schaltanwendungen
 BF256A-C: für VHF- und UHF Applikationen
 BFW10: sehr rauscharm bei niedriger Frequenz, gut geeignet für Differential-Verstärker
 J310: für AM-Eingangsstufen und UHF/VHF-Verstärker



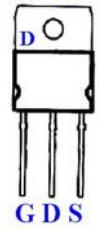
Best.Nr.	UDS(V)	ID(mA)	Ptot(mW)	IDSS(mA) @ UDS(V)	-U(P)GS(V)	gfs(mAV) @ f(Hz)	Geh.	Beschrieb	
BFW12	30	10	150	1 – 5	15	2 >	TO-72(3)	N-Kanal Sperrschicht FET für Verst. <300MHz	
BFW13		10	150	0.2 – 1.5		< 1.2			1 >
BFW10		20	300	8 – 20		< 8			3.5 – 6.5
2N3819	25	20	300	2 – 20	15	8	TO-92(8)	N-Kanal Sperrschicht FET für VHF + UHF	
BF981	20	25	225	4 – 25	15	2.5	SOT-103	N-Kanal Dual-Gate MOSFET VHF-Bereich	
BF961		30	200	25		4			12
BF982		40	225			1.3			20
BF960	20	30	225	2 – 20	10	3.5	SOT-103	N-Kanal Dual-Gate MOSFET UHF-Bereich	
BF980	18								7
BF246A	25	100	350	30 – 80	15	0.6 – 14.5	TO-92(5)	N-Kanal Sperrschicht FET für VHF + UHF	
BF246B				60 – 140					
BF246C				110 – 250					
BF247A	25	100	350	30 – 80	15	0.6 – 14.5	BF247	N-Kanal Sperrschicht FET für VHF + UHF	
BF247B				60 – 140					
BF247C				110 – 250					
J310	25		350	24 – 60	10	2 – 6.5	TO-92(8)	N-Kanal Sperrschicht FET für VHF + UHF	
BF256A	30	100	350	3 – 7	15	7.5 >	TO-92(6)	N-Kanal Sperrschicht FET für VHF + UHF	
BF256B				6 – 13					
BF256C				11 – 18					
BF244A	30	100	350	2 – 6.5	15	0.5 – 8	TO-92(5)	N-Kanal Sperrschicht FET für DC- + HF-Verst.	
BF244B				6 – 15					
BF244C				12 – 25					
BF245A	30	100	350	2 – 6.5	15	0.5 – 8	TO-92(6)	N-Kanal Sperrschicht FET für DC- + HF-Verst.	
BF245B				6 – 15					
BF245C				12 – 25					

N-Kanal	P-Kanal	UDS (V)	ID (mA)	Ptot (mW)	IDSS(mA) @ UDS(V)	-U(P)GS (V)	RDson (Ω)	Ton (ns)	Toff (ns)	Gehäuse	Beschrieb
2N4391		40		300	50 – 150	4 – 10	30	15	20	TO-18	Sperrschicht FET für Schaltanwendungen
2N4392					25 – 75	4 – 5	60	35			
2N4393					5 – 30	0.5 – 3	100	50			
BS170	BS250	-45	-180	830			14	4	10	TO-92(9)	Vertikal D-MOSFET für Schaltanwendungen
BS107		60	300	830			5	10	10		
BS107		200	120	830			28	10	25		
	BSS92	-200	-150	1000			20	20	50	TO-92(7)	
BS108		200	230	830			8	10	30	TO-92(9)	
BSS89		200	300	1000			6	80	145	TO-92(7)	
BSS125		600	100	1000			45			TO-92(7)	

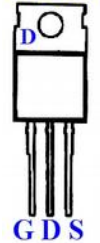
Leistungs-MOSFETs für Schaltanwendungen mit integrierter Schutzdiode

N-Kanal	P-Kanal	UDS(V)	ID(A)	Ptot(W)	RDSon(Ω)	gfs(A/V)	Tf(ns)	Geh.	
IRLZ14		60	10	43	0.2	3.5	42	TO-220	Logik-Level
IRL510		100	5.6	43	0.54	1.9	47	TO-220	Logik-Level
BUK452-100A		100	11	60	0.25	4.2	40	TO-220	Standard
IRLZ24		60	17	60	0.14	7.3	66	TO-220	Logik-Level
IRL520		100	9.2	60	0.27	3.7	38	TO-220	Logik-Level
BUK453-60A		60	22	75	0.08	6.5	80	TO-220	Standard
BUK453-100B		100	13	75	0.2	5.5	55	TO-220	Standard
	IRF9530	-100	-12	75	0.3	2	140	TO-220	Standard
BUK454-400B		400	4.2	75	1.8	2.5	40	TO-220	Standard
BUK454-500B		500	3.3	75	2.3	2.5	40	TO-220	Standard
IRL530		100	14	79	0.16	6.5	66	TO-220	Logik-Level
IRLZ34		60	30	88	0.05	13	84	TO-220	Logik-Level
BUK454-200A		200	9.2	90	0.4	5	60	TO-220	Standard
BUK455-400B		400	6.5	100	1	5.5	65	TO-220	Standard
BUK455-500B		500	5.3	100	1.5	4.5	65	TO-220	Standard
BUK455-600B		600	4	100	2.5	4.5	65	TO-220	Standard
	IRF9540	-100	-19	125	0.2	5	12	TO-220	Standard
	IRF9640	-200	-11	125	0.5	4	12	TO-220	Standard
BUK455-60A		60	41	125	0.04	13.5	130	TO-220	Standard
BUK436-60A		60	50	125	0.03	22	160	SOT-93	Standard
BUK455-100A		100	26	125	0.08	13.5	80	TO-220	Standard
BUK436-100A		100	33	125	0.06	16	85	SOT-93	Standard
BUK436-200A		200	19	125	0.16	16	70	SOT-93	Standard
BUK456-800A		800	4	125	3	4.3	60	TO-220	Standard
BUK436-800A		800	4	125	3	4.3	60	SOT-93	Standard
BUK456-1000B		1000	3.1	125	5	4.3	60	TO-220	Standard
BUK436-1000B		1000	3.1	125	5	4.3	60	SOT-93	Standard
IRLZ44		60	35	150	0.04	23	170	TO-220	Logik-Level
IRL540		100	28	150	0.08	13	84	TO-220	Logik-Level
BUK456-200B		200	17	150	0.2	16	70	TO-220	Standard
BUK437-400B		400	12	180	0.5	8	90	SOT-93	Standard

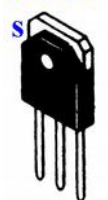
SOT-93



TO-220



TO-3P



Silizium Leistungs-MOSFETs für Verstärkeranwendungen mit integrierter Schutzdiode

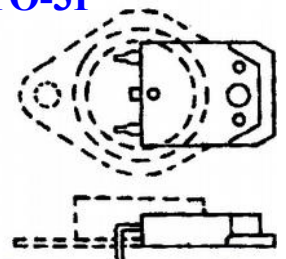
N-Kanal	P-Kanal	UDS (V)	ID (A)	Ptot (mW)	IDSS(A) @ UDS(V)	gfs(A/V)	Gehäuse
2SK1058	2SJ162	160	7	100	7	12	TO-3P

UDS(V)	Drain-Source Spannung
ID(A)	Drainstrom
Ptot(W)	Gesamtvverlustleistung
RDSon(Ω)	Dioden Serie-Widerstand
gfs(A/V)	Vorwärtssteilheit
Tf(ns)	Abfallzeit
IDSS(A)	Sättigungs-Drainstrom (Gate kurzgeschlossen)

UEB2(V)	Sperrspannung Emitter-Basis 2
IE(mA)	Emitterstrom
PD(mW)	Gesamtvverlustleistung
IP(μA)	Höckerstrom
Iv(mA)	Talstrom
rBB(kΩ)	Innerbasiswiderstand
n	Inneres Spannungsverhältnis
UGK(V)	Spannung Gate-Katode
UAK(V)	Spannung Anode-Katode
UT(V)	Offset-Spannung
IGA0(nA)	Talstrom- bzw Sperrstrom Gate-Anode

TO-3P

GSD



Montage an Stelle eines TO-3

Unijunction Transistoren

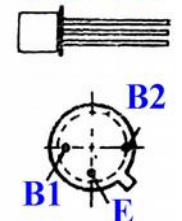
UJT-Transistoren oder Doppelbasisdioden werden vor allem als Triggerelemente für Thyristoren und Triacs eingesetzt. Sie können aber auch als Impulsgeneratoren und als Zeitgeber verwendet werden.

Best Nr	UEB2(V)	IE(mA)	PD(mW)	UEB1 (mV/A)	Ip(μA)	Iv(mA)	rBB(kΩ)	n	Gehäuse
2N2646	30	50	300	t3.5	5	4	4.7 – 9.1	0.56 – 0.75	TO-72
2N2647	30	50	300	t3.5	2	8	4.7 – 9.1	0.68 – 0.82	TO-72
2N4870	30	50	300	t2.5	5	2	4 – 9.1	0.56 – 0.75	TO-92(10)
2N4871	30	50	300	t2.5	5	4	4 – 9.1	0.68 – 0.82	TO-92(10)

TO92(10)



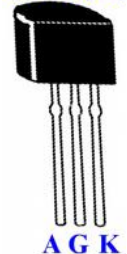
TO-72



TO-92(12)



TO-92(13)

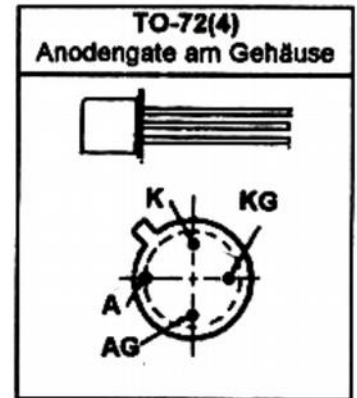
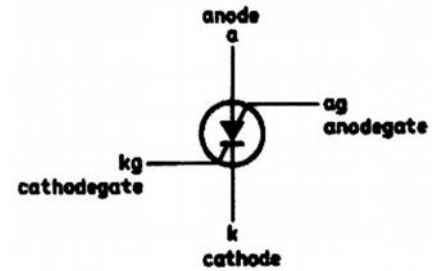


Programmierbare Unijunction Transistoren (PUT)

Best Nr	UGK(V)	UAK(V)	IE(mA)	PD(mW)	Ip(μA)	UT(V)	Iv(mA)	IGA0(nA)	Gehäuse
BRY56	+70	±70	175	300	5	1.4	100	10	TO-92 (12)
2N6027	+40	±40	150	300	5	1.6	1.5	100	TO-92 (13)
2N6028	+40	±40	150	300	1	0.6	1	100	TO-92 (13)

Fehler und Änderungen vorbehalten.
Bild kann vom Original abweichen

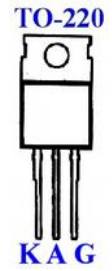
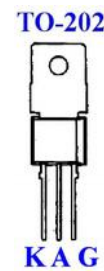
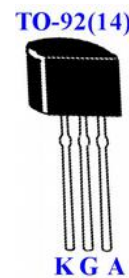
dI/dtc	Kritische Stromsteilheit beim Umpolen
dVD/dt	Kritische Spannungssteilheit
IFRM(A)	Periodischer Spitzen-Durchlassstrom
IGAT(μA)	Zündspannung Anodengate
IGKT(μA)	Zündspannung Kateodengate
IGT(mA)	Mindestzündstrom (Quadrat I+ III- bzw I- III+)
IH(mA)	Haltestrom
ITAV(A)	Dauergrenzstrom
ITRMS(A)	Höchster Durchlassstrom (effektiv)
ITSM(A)	Stossstrom-Grenzwert für eine einzige Sinusschwingung 10ms (50Hz)
Ptot(mW)	Gesamtvverlustleistung
UBO(V)	Durchbruchspannung
UD	Spannung Anode-Katode
UDRM(V)	Periodische Spitzensperrspannung in Vorwärtsrichtung
UGAT(V)	Zündspannung Anode-Anodengate
UGT(V)	Mindestzündspannung
UGKT(V)	Zündspannung Katode-Kateodengate
UR	Sperrspannung



Thyristor-Tetrode

Kann als extrem empfindlicher Thyristor, PNP-NPN (Schalt-) Transistorpaar (SCS), oder programmierbarer UJT-Transistor (PUT) verwendet werden.

Best Nr	UD=UR	IT(mA)	ITSM(A)	dIT/dt(A/us)	UGKT(V)	IGKT(μA)	-UGAT(V)	-IGAT(μA)	Gehäuse
BRY39	70	250	3	20	0.5	1	1	100	TO-72(4)



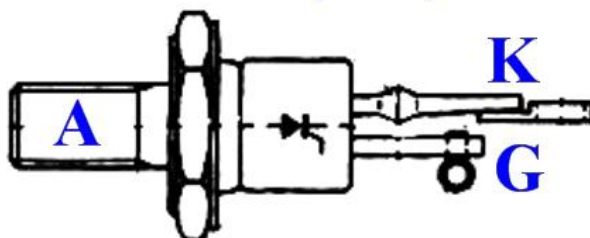
DIAC

Triggelement für Thyristoren und Triacs

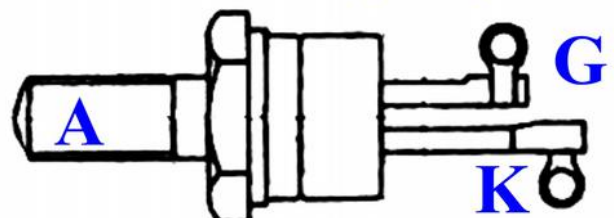
Best Nr	UBO(V)	IFRM(A)	Ptot(m W)
BR100-03	28 – 36	2	150

Best Nr	1) Grenzwerte				Kennwerte					Gehäuse
	UDRM(V) URRM(V)	ITAV(A)	ITRMS(A)	ITSM(A)	dVD/dt (V/us)	IH(mA)	IGT(mA)		UGT(V)	
							min	max		
X0102NA	R800	0.5	0.8	8	25	5		0.2	0.8	TO-92(14)
X0403NE	R800	2.5	4	30	30	5	0.02	0.2	0.8	TO-202
S0402NH	R800	2.5	4	50	5	10		0.2	2	TO-220
S0802NH		5.1	8	80	5	10		0.2	2	
S0806NH		5.1	8	80	5	10	0.5	5	2	
S1210NH	R800	7.6	12	120	20	38	10	25	2	TO-220
BTW42-600R	600	10	16	150	500	75	50		1.5	TO-64 (M5)
S1610NH	R800	10	16	160	400	38	10	25	2	TO-220
S2516NH	R800	16	25	250	500	75	20	50	2.5	TO-220
BTW40-600R	600	20	32	400	100	75	75		1.5	TO-48 (M6)
S4016NH	R800	25	40	380	500	75	20	50	2.5	TO-220

TO-48 (M6)



TO-64 (M5)



UDRM(V)	Periodische Spitzensperspannung in Vorwärtsrichtung
ITRMS(A)	Höchster Durchlassstrom (effektiv)
ITSM(A)	Stossstrom-Grenzwert für eine einzige Sinusschwingung 10ms (50Hz)
dVD/dt(V/us)	Kritische Spannungssteilheit
di/dtc(A/ms)	Kritische Stromsteilheit beim Umpolen
IH(mA)	Haltestrom
IGT(mA) Q1-Q4	Mindestzündstrom (Quadrat I+ III- bzw. I- III+)
UGT(V)	Mindestzündspannung

Best Nr	UDRM(V)	ITRMS(A)	ITSM(A)	dVD/dt (V/us)	di/dtc (A/ms)	IH(mA)	IGT(mA)				UGT(V)	Gehäuse
							Q1	Q2	Q3	Q4		
Z0102NA	R800	0.8	20	10		3	3	3	3	2	TO-92	
Z0302MG	R600	3	20	100		25	25	25	25	2	TO-92	
Z0405NE	R800	4	22	30		5	5	5	5	2	TO-202	
T0805NH	R800	8	70	10		5	5	5	5	2.5	TO-220	
T0806NH	R800	8	100	20	1.8	5	5	5	5	1.5	TO-220 (HC2)	
T0810NJ	R800	8	100	200		25	25	25	25	2.5	TO-220 isoliert	
T1210NH	R800	12	110	200		25	25	25	25	2.5	TO-220	
T1212NH	R800	12	110	500		50	50	50	50	2.5	TO-220	
T1214NH	R800	12	110	500	7	35	35	35	35	1.5	TO-220 (HC2)	
T1212NJ	R800	12	120	500		50	50	50	50	2.5	TO-220 isoliert	
T1612NH	R800	16	150	500		50	50	50	50	2.5	TO-220	
T1612NJ	R800	16	210	500		50	50	50	50	2.5	TO-220 isoliert	
T1616NJ	R800	16	250	750	14	50	50	50	50	1.5	TO-220 (HC2 isoliert)	
T2512NK	R800	25	190	500		50	50	50	50	2.5	RD-101 isoliert	
T2512NH	R800	25	250	500		50	50	50	50	2.5	TO-220	
T4012NK	R800	40	300	500		50	50	50	50	2.5	RD-101 isoliert	

